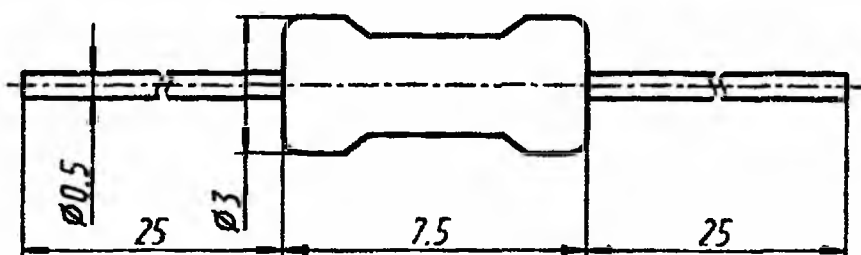


1Д508А, ГД508А, ГД508Б

Диоды германиевые, микросплавные, импульсные. Предназначены для применения в сверхбыстродействующих формирователях импульсов. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода не более 0,2 г.

1Д508А, ГД508(А,Б)



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение, не более:

при $I_{пр} = 1$ мА, $T = +25$ °С для 1Д508А 0,4 В

при $I_{пр} = 10$ мА:

$T = +25$ и $+70$ °С для 1Д508А,

$T = +25$ и $+55$ °С для ГД508А 0,7 В

$T = +25$ и $+55$ °С для ГД508Б 0,65 В

$T = -60$ °С для 1Д508А, $T = -40$ °С

для ГД508А 0,9 В

$T = -40$ °С для ГД508Б 0,85 В

Импульсное прямое напряжение при

$I_{пр, и} = 30$ мА для 1Д508А, $I_{пр, и} = 12$ мА

для ГД508А, ГД508Б, не более 1,5 В

Постоянный обратный ток, не более:

при $U_{обр} = 8$ В:

$T = -60$ и $+25$ °С для 1Д508А,

$T = -40$ и $+25$ °С для ГД508А 60 мкА

$T = -40$ и $+25$ °С для ГД508Б 100 мкА

$T = +70$ °С для 1Д508А, $T = +55$ °С

для ГД508А 150 мкА

$T = +55$ °С для ГД508Б 250 мкА

при $U_{обр} = 5$ В, $T = +25$ °С для 1Д508А 20* мкА

Заряд переключения при $I_{пр} = 10$ мА,

$U_{обр, и} = 5$ В, не более 20 пКл

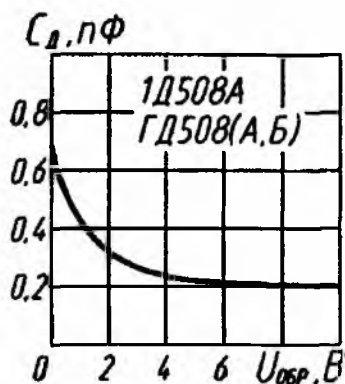
Общая емкость диода при $U_{\text{обР}} = 0,5 \text{ В}$,
не более 0,75 пФ

Предельные эксплуатационные данные

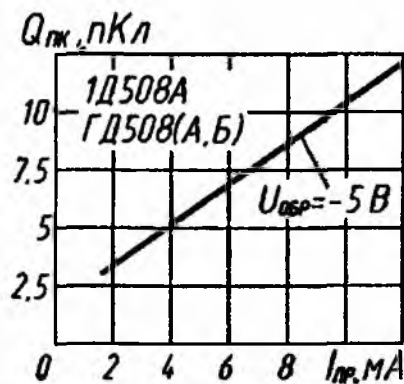
Постоянное обратное напряжение	8 В
Импульсное обратное напряжение при $t_{\text{и}} \leq 5 \text{ мкс}$, $Q \geq 4$	10 В
Постоянный или средний прямой ток.....	10 мА
Импульсный прямой ток при $t_{\text{и}} \leq 10 \text{ мкс}$	30 мА
Температура окружающей среды:	
1Д508А	-60...+70 °С
ГД508А, ГД508Б	-40...+55 °С

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса.
Растягивающая выходы сила не должна превышать 14,7 Н.

Пайка (сварка) выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. Температура корпуса при пайке не должна превышать +70 °С.



Зависимость общей емкости диода от напряжения



Зависимость заряда переключения от импульсного прямого тока